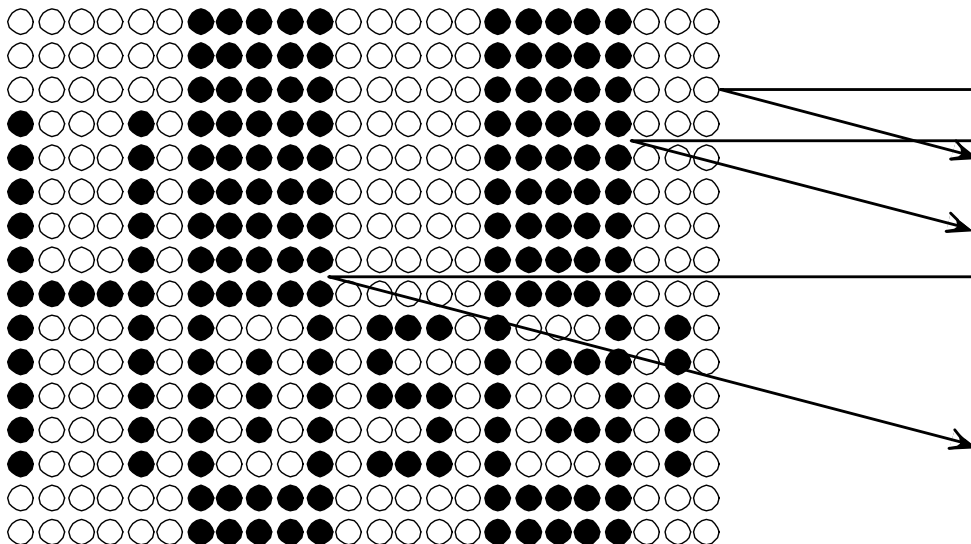


第 31 回法政大学
イオンビーム工学研究所シンポジウム

The 31st Symposium on Materials Science and Engineering
Research Center of Ion Beam Technology
Hosei University

PROGRAM



期日 2012年12月5日(水)
会場 法政大学 小金井キャンパス
西館地下1階マルチメディアホール
主催 法政大学イオンビーム工学研究所

I	10 : 30~12 : 00
招待講演 I	
集束イオンビーム二次イオン質量分析装置の開発と大気微粒子の個別粒子分析への応用 (45分) 工学院大学	坂本 哲夫
招待講演 II	
機能材料開発におけるイオンビーム利用 (45分) 法政大学	坂本 勲
昼食	12 : 00~13 : 00
II	13 : 00~13 : 45
招待講演 III	
グラフェンの低温プラズマCVD合成 (45分) 産業技術総合研究所	長谷川 雅孝
休憩	13 : 45~14 : 00
III ショート講演 (各5分)	14 : 00~14 : 40
<ol style="list-style-type: none"> 1. ラザフォード後方散乱分析法(RBS)による固体高分子型燃料電池排出水中の不純物原子分析(II) 東京工業大学、東京都市大学*、放射線医学総合研究所** °川崎 克則、鳥山 保*、 服部俊 幸**、高木 靖雄*、福田 一志、小栗 慶之、実吉 啓二 2. 高温イオン注入したFe触媒微粒子からの熱フィラメントCVDによるCNTの低温成長 神奈川大学 °刈部 真里、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治 3. 集束イオンビーム二次イオン質量分析装置によるコバルト化合物のスペクトル比較 工学院大学 °大西 美和、坂本 哲夫 4. ダイヤモンド半導体の電気特性評価のための電極構造の検討 神奈川大学 °仲野 晴菜、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治 5. 表面光吸収法を用いた GaAs 半導体による負の電子親和力表面形成過程のその場観察 東京理科大学、名古屋大学* °早瀬 和哉、西谷 智博*、鈴木 一成、今井 啓修、 長谷川 順一、難波 大貴、目黒 多加志 6. STM, RHEED による Co/Graphite 表面観察 神奈川大学 °山下 友実、石井 孝俊、桑田 大輔、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治 7. Textured surface での NEA(negative electron affinity) 東京理科大学、理化学研究所* °平尾 昌幸、早瀬 和哉、関田 冬人、山谷 悠人、 塩川 高雄*、秋本 彦太*、目黒 多加志 8. マイクロ波プラズマCVDによるCNTの低温成長 神奈川大学 °谷地田 剛介、星野 靖、斎藤 保直、中田 穰治 	
休憩	14 : 40~14 : 55

9. 密度汎関数法によるダイヤモンド半導体中の不純物準位の計算
神奈川大学 白井 彰眞、石倉 光博、星野 靖、齋藤 保直、中田 穰治
10. Ohmic contacts to lightly doped p/n-Type 4H-SiC
Hosei University °A. Matsui, T. Sugimachi, T. Nishimura, T. Nakamura
11. 中性子転換注入 GaN 中の ^{14}C による Ge-DX 様センターの補償
法政大学、大阪教育大学*、京都大学**
°伊田 孝寛、尾賀 孝宏、栗山 一男、串田 一雅*、徐 虬**、福谷 哲**
12. MBE 法による低転位 SiGe 単結晶の作製と評価
法政大学、産業技術総合研究所*
°渡邊 与典、大島 隆治*、坂田 功*、松原 浩司*、坂本 勲
13. シリコンゲルマニウムの固相成長速度に関する分子動力学解析
法政大学 °吉丸 泰正、松本 裕貴、山本 康博
14. イオン注入法を用いた GaN FET の高性能化に関する研究
法政大学 °葛西 駿、小川 弘貴、野本 一貴、中村 徹
15. Ge イオン注入 ZnO バルク単結晶の核反応分析
法政大学、大阪教育大学*、産業技術総合研究所**
°上岡 一馬、尾賀 孝宏、井澤 佑介、栗山 一男、串田 一雅*、木野村 淳**
16. IBIEC による SiGe/Si の再結晶化
法政大学 °栗根 和隆、関根 渉、宮下 道子、山本 康博
17. 低オン抵抗 GaN p-n ダイオードにおけるフォトンリサイクリング効果の傍証
法政大学、日立電線*、日立中央研究所** °石田 祐也、三島 友義*、望月 和浩**、
畠山 義智、野本 一貴、金田 直樹*、土屋 忠厳*、中村 徹
18. プロトン照射 GaN 単結晶薄膜の熱刺激電流測定
法政大学、大阪教育大学* °中村 司、伊田 孝寛、上岡 一馬、栗山 一男、串田 一雅*
19. ZnOFe/ZnO 膜の構造及び磁気特性
法政大学、産業技術総合研究所*、島根大学**
°中山 浩、坂本 勲、木下 量介、安本 正人*、小池 正記*、本多 茂男**
20. イオン注入法による GaN MISFET の素子分離に関する研究
法政大学 °小川 弘貴、葛西 駿、野本 一貴、中村 徹
21. スパッタ法により形成した Al 添加 CeO₂ 薄膜の結晶性評価
法政大学、コメント* °蒲田 大生、岡崎 拓也、原 健太、野谷 祐貴、
鈴木 撰*、石橋 啓次*、山本 康博
22. スパッタ法により形成した Al 添加 CeO₂ 薄膜の電気特性評価
法政大学、コメント* °岡崎 拓也、蒲田 大生、野谷 祐貴、原 健太、
鈴木 撰*、石橋 啓次*、山本 康博
23. Si⁺イオン注入 p-GaN の電気特性
法政大学 °山内 一樹、福田 俊、小川 弘貴、野本 一貴、中村 徹

24. 水素イオン注入 ZnO バルク単結晶の電気伝導特性の評価

法政大学、大阪教育大学*

°甲斐田 卓也、上岡 一馬、伊田 孝寛、栗山 一男、串田 一雅*

25. 2D carbon nanostructures grown by microwave plasma-enhanced chemical vapor deposition and their applications

Hosei University

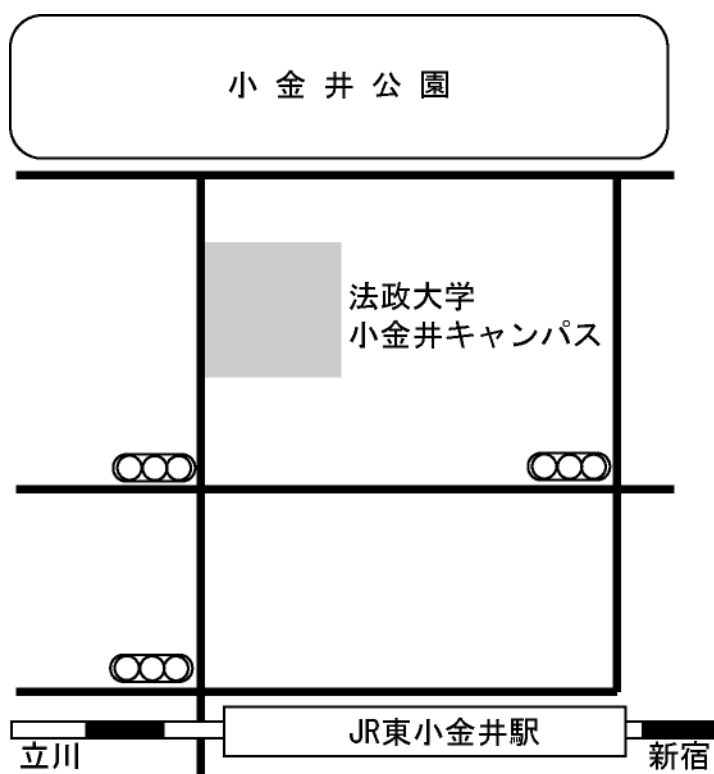
°Zhipeng Wang, Shohei Hayase, Mao Shoji, Hironori Ogata

17 : 00~

懇親会

東館地下1F 生協食堂にて

交通案内



JR 東小金井駅北口より徒歩12分
京王バスまたは CoCo バス「法政大学」下車

法政大学イオンビーム工学研究所

〒184-8584 東京都小金井市梶野町 3-7-2

Tel: 042-387-6094 Fax: 042-387-6095

E-mail: ion-sympo@ml.hosei.ac.jp